

0.1 電流と磁場 2

1. 磁気力に関するクーロンの法則

磁気の中で昔から知られていたものはもちろん磁石の作用である。磁石の働きは、その N 極と S 極にそれぞれ正と負の磁荷があって、正と正、負と負の磁荷の間には斥力が働き、正と負の磁荷の間には引力が働くと考えれば説明できる。この磁気力の定量的な研究は、静電気力のとて同じくクーロンによって行われた。クーロンは以下のことを確かめた。

2つの磁荷の間にはたらく磁気力の大きさ F (N) は、磁荷の磁気量をそれぞれ m_1, m_2 , 磁荷間の距離を r (m) とすると、

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (\text{N})$$

である。これもクーロンの法則である。ここで μ_0 は真空の透磁率であり、

$$\frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} = c^2$$

という関係式がある (c は光の速さ)。

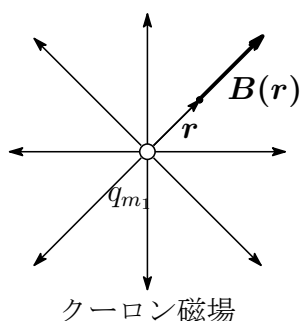
また、この式を、静電場と同様に、磁荷が周囲の空間に磁場をつくり、その磁場が第二の磁荷に力を及ぼす、という形に書き表すことができる。原点 O にある磁荷 q_{m_1} が、 O から距離 r (m) のところに、以下の大きさをもつ磁場

$$B(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_{m_1}}{r^2} \dots (a)$$

をつくり (向きは図の向き), その点に置かれた磁荷 q_{m_2} は磁場から以下の大きさの力

$$F = q_{m_2} B(r) \dots (b)$$

を受ける、と考えればよい (向きも同じ)。なお、ここまであえて磁荷の単位を書かないでおいしたのは、次のローレンツ力を紹介するまで、定義できないからであった。



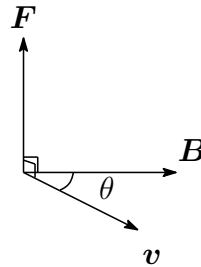
2. ローレンツ力

磁場 B の中で動く電荷 q (C) の速度を v とし, v と B の間の角度を θ とする。実験によると, 電荷が受ける力 F の大きさは $qvB \sin \theta$ に比例する。 F の方向は, v と B に直交し, $q > 0$ のときには v から B へ廻す右ねじの進む向きを向く。これらの性質を外積の記号 \times を用いて表すと,

$$F = \alpha qv \times B$$

と表すことができる。ここで α は比例定数である。

ローレンツ力



ここで B の単位であるが, $\alpha = 1$ とすれば定義することができて, 実際それで定義された。こうして定められた B の単位を, T (テスラ) あるいは Wb/m^2 と呼ぶ。 Wb は「ウェーバー」と読む。

さて B の単位をこのように定義すると, ローレンツ力は

$$F = qv \times B \cdots (c)$$

と表される。なお, B の正式の名前は**磁束密度**であるが, 単に磁場と呼ぶことも多い。

すると, 1. における磁荷の単位を決めることができる。(b) と (c) を比べると, qv と m_2 の単位が同じである。これと $C = A \times s$ より, 磁荷の単位は $A \cdot m$ となる。また, (c) の単位をみると,

$$[N] = [A \times m] \cdot [Wb/m^2]$$

より,

$$[Wb] = [N \cdot A/m]$$

という関係にあることがわかる。

なお, 磁場の強さ H (N/Wb) というものも定義されている。これは, 電場の強さ E (N/C) の磁場バージョンであるが, 以下の関係式が成り立つので, 以下の式を覚えた上で, B で統一しておくとうわかりやすい。

$$B = \mu H \quad (\mu \text{は物質の透磁率。真空の場合は} \mu_0 \text{である})$$

3. ビオ・サバルの法則

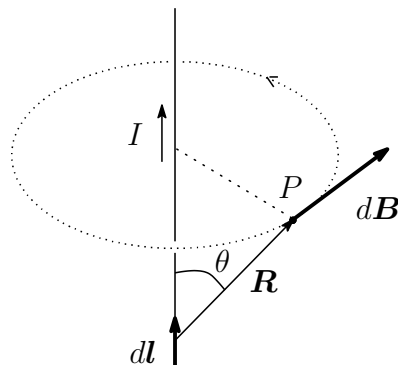
電流要素がつくる磁場を記述する法則であり、次の式で表される。

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_C \frac{d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2}$$

ここで、

\mathbf{B} : 図の点 P に作られる磁場。

$\hat{\mathbf{R}}$: \mathbf{R} は回路の微小部分 $d\mathbf{l}$ から P へのベクトル, $\hat{\mathbf{R}}$ は \mathbf{R} 方向の単位ベクトルである。



ベクトルの外積の形で書くとややこしいので、次のように大きさを考えてもよい。図の $d\mathbf{B}$ の大きさは、 $d\mathbf{l}$ と \mathbf{R} のなす角を θ とすれば、

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{R^2}$$

である（単位はそれぞれ標準単位系）。向きは、図の向きを覚えるとよい。電流の進む向きに右ねじが進むとき、ねじ頭の回る方向である。

例 1 : 直線電流の作る磁場

直線電流 I から距離 d 離れた点 P における磁場を求める。直線電流の微小部分 dl が P につくる磁場 $d\mathbf{B}$ は、図のように紙面の表から裏へ向き、その大きさは、ビオ・サバルの法則より、

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi R^2}$$

である。これを全ての dl について加え合わせればよい。図より

$$\frac{dl \sin \theta}{R^2} = \frac{R d\theta}{R^2} = \frac{d\theta}{R} = \frac{\sin \theta d\theta}{d}$$

なので、

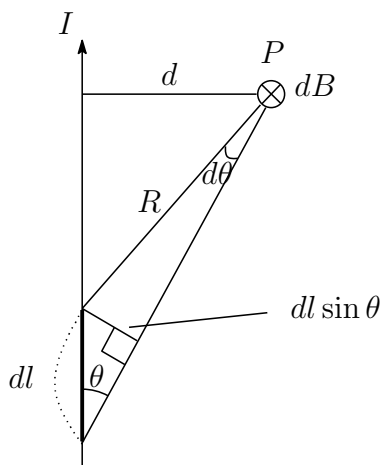
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I dl \sin \theta}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

となる。よって、

直線電流 I (A) が、距離 d (m) だけ離れたところで作る磁場の大きさを B (Wb) とする。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

が成り立つ。



例 2 : 円電流が中心軸上に作る磁場

半径 a の円形回路に電流 I が流れる場合を考える。まず、円の中心における磁場を求めると、微小部分 dl が中心に作る磁場の大きさは、ビオ・サバルの法則より

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi a^2}$$

であり、中心軸の方向になる。向きは、図のように、円電流に関して右ねじが進む向きとなる。 dl について 1 周分加え合わせると、円周の長さは $2\pi a$ なので、円電流が中心に作る磁場の大きさは、

$$B = \frac{\mu_0 I}{2a}$$

となる。

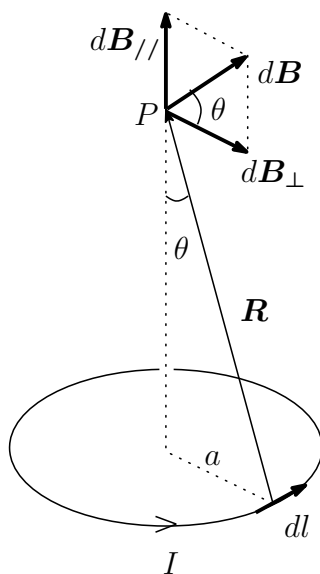
おまけで、中心軸上の任意の点 P の磁場を考えてみる。図にあるように、 P から円周までの距離を R とすると、微小部分 dl がこの点に作る磁場 $d\mathbf{B}$ の軸方向の成分 $d\mathbf{B}_{//}$ の大きさは、図に示す角度 θ を用いて、

$$dB_{//} = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi R^2} \sin \theta = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi a^2} \sin^3 \theta$$

となる。 dl について加え合わせると、

$$B_{//} = \frac{\mu_0 I}{2a} \sin^3 \theta$$

となる。 $d\mathbf{B}_{\perp}$ は対称性から相殺されて 0 になるので、これがそのまま点 P における磁場の大きさになる。方向は中心軸の方向となる。



4. アンペールの法則

ビオ・サバールの法則から導かれる。任意の閉曲線 C に沿う磁場の循環 $\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ と、閉曲線 C に絡む電流の関係を示したものであり、以下の式で表される。

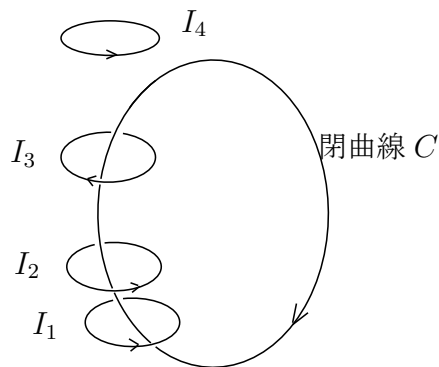
$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$$

ここで、 I は閉曲線 C と絡む電流の代数和である。 C と正の向きに絡む電流には $I_i > 0$ 、 C と負の向きに絡む電流には $I_i < 0$ と符号をつける。 C と絡まない電流には $I_i = 0$ とする。

例えば次の図の場合では、

$$I = I_1 + I_2 - I_3$$

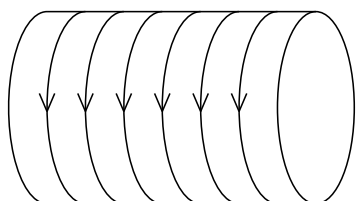
となる。



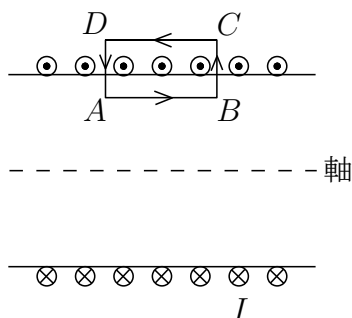
高校の物理においては、次の一例のみ登場する。

例：無限に長いソレノイドの内部の磁場

円筒に導線を密に巻いたコイルをソレノイドと呼ぶ。軸方向の単位長さ当たりの導線巻き数を n (回/ m) とし、導線に流れる電流を I とする。対称性から、ソレノイド内部の磁場は軸と平行で、大きさは中心軸からの距離のみによると考えてよい。また、外部の磁場は 0 とする。



ソレノイド



ソレノイドの断面図

図の四角形 $ABCD$ にアンペールの法則を適用すると、法則の左辺の積分に関与するのは辺 AB だけなので、辺 AB 上の磁場を B とすると、

$$B = \mu_0 n I$$

を得る。これは、磁場が中心軸からの距離にも依らないことを示している。

まとめると、

ソレノイドを貫く磁場の大きさ B (Wb) は、単位長さ当たりの導線巻き数を n (回/ m)、導線に流れる電流を I (A) とするとき、

$$B = \mu_0 n I$$

である。